

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

New York, New York

Katsuhiki MIYA, et al.

Date: August 27, 2003

Serial No.:

Group Art Unit: --

Filed:

Examiner: --

For: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS AND SUBSTRATE PROCESSING
METHOD DRYING SUBSTRATE

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:

In accordance with 35 U.S.C. §119, Applicants confirm the prior request for priority under the International Convention and submits herewith the following document in support of the claim:

CERTIFIED JAPANESE APPLICATION NO. 2002-251101 FILED AUGUST 29, 2002

CERTIFIED JAPANESE APPLICATION NO. 2003-192898 FILED JULY 7, 2003

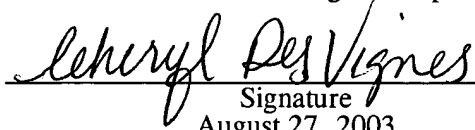
EXPRESS MAIL CERTIFICATE

Respectfully submitted,

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as Express Mail Post Office to Addressee (mail label #EV342530458US in an envelope addressed to: Mail Stop Patent Application, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on August 27, 2003

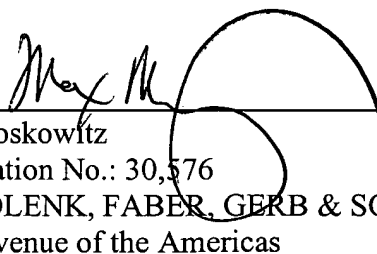
CHERYL DESVIGNES

Name of Person Mailing Correspondence


Signature
August 27, 2003

Date of Signature

Enclosures


Max Moskowitz
Registration No.: 30,576
OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN, LLP
1180 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-8403
Telephone: (212) 382-0700

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 7 日
Date of Application:

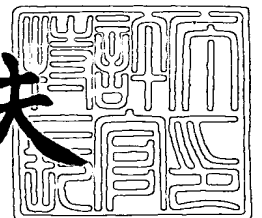
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 9 2 8 9 8
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 1 9 2 8 9 8]

出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 5 7 8 1 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 P15-1769

【提出日】 平成15年 7月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/304
B08B 3/02

【発明者】

【住所又は居所】 京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の
1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】 宮 勝彦

【発明者】

【住所又は居所】 京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の
1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】 泉 昭

【特許出願人】

【識別番号】 000207551

【氏名又は名称】 大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089233

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 茂明

【選任した代理人】

【識別番号】 100088672

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉竹 英俊

【選任した代理人】

【識別番号】 100088845

【弁理士】

【氏名又は名称】 有田 貴弘

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-251101

【出願日】 平成14年 8月29日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012852

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9005666

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板処理装置および基板処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 回転する基板に流体を供給して所定の処理を行う基板処理装置であって、

基板を保持して回転させる基板保持回転手段と、

基板に対応する平面形状および大きさを有し、前記基板保持回転手段に保持された基板の少なくとも一方の面に対向し近接して配置され、基板の当該面の中央部へ処理液および気体をそれぞれ吐出する処理液吐出口および気体吐出口が形設された雰囲気遮断部材と、

を備え、

前記雰囲気遮断部材の、平面視で前記気体吐出口の外側に、前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面へ気体を吐出する外側気体吐出口を形設することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の基板処理装置において、

前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気遮断部材に形設することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の基板処理装置において、

前記到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気遮断部材に形設することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 4】 請求項 3 記載の基板処理装置において、

前記外側気体吐出口からの気体の吐出が前記気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始されることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 5】 請求項 1 記載の基板処理装置において、

前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気

気遮断部材に形設することを特徴とする基板処理装置。

【請求項 6】 請求項 5 記載の基板処理装置において、

前記気体吐出口および前記外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体が吐出されることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 7】 請求項 1 から請求項 6 のいずれかに記載の基板処理装置において、

前記外側気体吐出口から吐出される気体の流量が、前記気体吐出口から吐出される気体の流量より大きいことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 8】 請求項 1 から請求項 7 のいずれかに記載の基板処理装置において、

平面視で前記雰囲気気遮断部材を支持する支持筒の内側に前記気体吐出口および前記外側気体吐出口が配置されていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 9】 回転する基板に流体を供給して所定の処理を行う基板処理方法であって、

基板保持回転手段によって基板を回転させる工程と、

基板に対応する平面形状および大きさを有する雰囲気気遮断部材を、基板保持回転手段に保持された基板の少なくとも一方の面に対向させ近接させて配置する工程と、

前記雰囲気気遮断部材に形設された処理液吐出口から前記基板保持回転手段によって回転される基板の当該面の中央部へ処理液を吐出する工程と、

前記雰囲気気遮断部材に形設された気体吐出口から前記基板の当該面の中央部へ気体を吐出する工程と、

前記雰囲気気遮断部材に平面視で前記気体吐出口の外側に形設された外側気体吐出口から前記基板の当該面へ気体を吐出する工程と、
を備えることを特徴とする基板処理方法。

【請求項 10】 請求項 9 記載の基板処理方法において、

前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍となるように前記外側気体吐出口が前記雰囲気気遮断部材に形設され、

前記外側気体吐出口からの気体の吐出が前記気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始されることを特徴とする基板処理方法。

【請求項 1 1】 請求項 9 記載の基板処理方法において、

前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍となるように前記外側気体吐出口が前記雰囲気遮断部材に形設され、

前記気体吐出口および前記外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体が吐出されることを特徴とする基板処理方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体ウエハ、光ディスク用基板等の基板を回転させながら、その基板へ薬液や純水などの処理液を供給して洗浄等の処理を行い、その処理後にまたは処理中から基板へ窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどの気体を供給して、基板を乾燥させる基板処理装置および基板処理方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

この種の基板処理装置としては、従来、例えば、図 1 2 に一部を省略した概略正面図を、図 1 3 に要部の縦断面図を、図 1 4 に図 1 3 の XI-XI 矢視断面図をそれぞれ示すような構成の装置が使用されている。この例示した装置は、基板の上・下両面に対して薬液による洗浄処理、純水によるリンス処理およびスピンドライ方式による乾燥処理をそれぞれ施す枚葉式の基板処理装置である。

【 0 0 0 3 】

この基板処理装置は、基板、例えば半導体ウエハ W を水平姿勢に保持して回転させるスピンチャック 1 0 0 と、このスピンチャック 1 0 0 に保持されたウエハ W の上面に対向し近接して配置される雰囲気遮断部材 1 0 2 とを備えている。雰囲気遮断部材 1 0 2 は、その平面形状がウエハ W に対応する大きさの円板状をなしている。

【 0 0 0 4 】

スピンチャック 100 は、ウエハ W を上面側に保持する円板状のスピンベース 104 と、このスピンベース 104 の下面側中央部に垂設された円筒状の回転筒 106 とから構成されている。スピンベース 104 の上面側周縁部には、ウエハ W の周縁部を把持してウエハ W をスピンベース 104 の上面から離間させた状態で保持する 3 本以上のチャックピン 108 が、円周方向に等配されて植設されている。このスピンベース 104 が、それに保持されたウエハ W の下面に対向し近接して配置される雰囲気遮断部材としての機能も果たす。回転筒 106 は、モータ 110、このモータ 110 の回転軸に固着された駆動プーリ 112、回転筒 106 の外周面側に嵌着された従動プーリ 114、および、駆動プーリ 112 と従動プーリ 114 とに掛け回されたベルト 116 からなる回転駆動機構により、鉛直方向の軸心線回りに回転させられるようになっている。そして、回転筒 106 が回転することにより、スピンベース 104 と共にウエハ W が回転するようになっている。回転筒 106 の中空部には、細長い円柱状の内挿軸 118 が挿通されている。内挿軸 118 は、固定されて立設されており、内挿軸 118 と回転筒 106 とは同心に配置され、内挿軸 118 の外周面と回転筒 106 の内周面との間にベアリング（図示せず）が介在して取着されている。

【0005】

雰囲気遮断部材 102 は、円筒状の回転支持筒 120 の下端に接続されている。図 12 には詳細な構造を図示していないが、回転支持筒 120 の中空部には、上記したスピンチャック 100 の回転筒 106 と同様に、細長い円柱状の内挿軸 122 が挿通されており、内挿軸 122 と回転支持筒 120 とは同心に配置され、内挿軸 122 の外周面と回転支持筒 120 の内周面との間にベアリング（図示せず）が介在して取着されている。回転支持筒 120 は、支持アーム 124 の先端部に懸垂状態で、かつ、モータ 126 によって鉛直方向の軸心線回りに回転可能に支持されている。そして、モータ 126 によって回転支持筒 120 が回転させられることにより、雰囲気遮断部材 102 が回転支持筒 120 と共に回転するようになっている。また、回転支持筒 120 および支持アーム 124 は、図示しないエアシリンダ等の直線駆動機構からなる昇降駆動装置によって上下方向へ往復移動させられるように構成されている。そして、回転支持筒 120 が上下方

向へ往復移動することにより、雰囲気遮断部材 102 がスピンベース 104 上のウエハ W の上面に対して近接および離間するようになっている。

【0006】

回転支持筒 120 の中空部に挿通された内挿軸 122 には、その軸心部に処理液供給路 128 が形設されており、その処理液供給路 128 の、スピンベース 104 上に保持されたウエハ W の上面と対向する下端が処理液吐出口 130 となる。また、内挿軸 122 の外周面と回転支持筒 120 の内周面との間に形成される空間部分が気体供給路 132 を構成し、その気体供給路 132 の下端が、環状の気体吐出口 134 となる。同様に、スピンチャック 100 の回転筒 106 の中空部に挿通された内挿軸 118 には、その軸心部に処理液供給路 136 が形設されており、その処理液供給路 136 の、スピンベース 104 上に保持されたウエハ W の下面と対向する上端が処理液吐出口 138 となる。また、内挿軸 118 の外周面と回転筒 106 の内周面との間に形成される空間部分が気体供給路 140 を構成し、その気体供給路 140 の上端が、環状の気体吐出口 142 となる。そして、各処理液供給路 128、136 は、薬液や純水などの処理液の供給を行う処理液供給部 144 にそれぞれ流路接続されている。また、各気体供給路 132、140 は、窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどのプロセスガスの供給を行う気体供給部 146 にそれぞれ流路接続されている。

【0007】

上記した基板処理装置による処理動作は、例えば以下のようにして行われる。スピンチャック 100 のスピンベース 104 上にウエハ W を保持してウエハ W を水平面内で鉛直軸回りに回転させる。そして、処理液供給部 144 から各処理液供給路 128、136 へ薬液を供給し、雰囲気遮断部材 102 の下面およびスピンベース 104 の上面にそれぞれ開口した各処理液吐出口 130、138 からウエハ W の上・下両面の各中心部に向けて薬液がそれぞれ吐出される。ウエハ W の上・下両面の各中心部に向けてそれぞれ吐出された薬液は、ウエハ W の回転に伴う遠心力によってウエハ W の全面にそれぞれ拡げられ、ウエハ W の上・下両面がそれぞれ薬液によって洗浄処理される。

【0008】

薬液による洗浄処理が終わると、処理液供給部 144 から各処理液供給路 128、136 へ供給していた薬液を純水に切り替え、各処理液吐出口 130、138 からウエハ W の上・下両面の各中心部に向けて純水をそれぞれ吐出させる。ウエハ W の上・下両面の各中心部に向けてそれぞれ吐出された純水は、ウエハ W の回転に伴う遠心力によってウエハ W の全面にそれぞれ拡げられ、ウエハ W の上・下両面がそれぞれ純水によってリンス処理される。なお、上記した薬液洗浄処理および／または純水リンス処理の際に、必要に応じて、気体供給部 146 から各気体供給路 132、140 へ窒素ガス等のプロセスガスを供給し、雰囲気遮断部材 102 の下面およびスピンベース 104 の上面にそれぞれ開口した環状の各気体吐出口 134、142 からウエハ W の上・下両面に向けてプロセスガスをそれぞれ吐出させる。

【0009】

純水によるリンス処理が終わると、各処理液吐出口 130、138 からの純水の吐出をそれぞれ停止させ、気体供給部 146 から各気体供給路 132、140 へプロセスガスを供給し、環状の各気体吐出口 134、142 からウエハ W の上・下両面に向けてプロセスガスをそれぞれ吐出させながら、ウエハ W を回転させ、ウエハ W の回転に伴う遠心力によって、ウエハ W の上・下両面に残留する純水をウエハ W の周縁部から振り切って除去し、ウエハ W の上・下両面をそれぞれ乾燥させる。このとき、各気体吐出口 134、142 からウエハ W の上・下両面に向けてそれぞれ吐出されるプロセスガスが、ウエハ W の上・下両面にそれぞれ沿って流れ、ウエハ W の全面に拡がって、ウエハ W の乾燥が促進される。

【0010】

また、例えば、特許文献 1 には、図 13 および図 14 に示したものと異なる構成の処理液吐出部および気体吐出部を有する基板処理装置が開示されている。すなわち、特許文献 1 に記載された装置では、図 16 に要部の縦断面図を、図 17 に図 16 の XIV-XIV 矢視断面図をそれぞれ示すように、雰囲気遮断部材 148 が下端に接続された回転支持筒 150 の中空部に挿通された内挿軸 152 に、その内挿軸 152 の軸心から軸心がずれるように気体供給路 154 が形設されている。そして、雰囲気遮断部材 148 の、スピンチャック 162 のスピンベース 1

64 上に保持されたウエハWの上面と対向する面（下面）に気体吐出口156が開口しており、その気体吐出口156の中心は、ウエハWの中心からずれている。また、内挿軸152には、気体供給路154の側方に並んで処理液供給路158が形設されており、雰囲気遮断部材148の、ウエハWの上面との対向面に処理液吐出口160が、気体吐出口156に隣接して開口している。

【0011】

同様に、スピンチャック162の回転筒166の中空部に挿通された内挿軸168には、その内挿軸168の軸心から軸心がずれるように気体供給路170が形設されており、スピンベース164の、それに保持されたウエハWの下面と対向する上面に、ウエハWの中心から偏心するように気体吐出口172が開口している。また、内挿軸168には、気体供給路170の側方に並んで処理液供給路174が形設されており、スピンベース164の上面に、気体吐出口172に隣接して処理液吐出口176が開口している。

【0012】

【特許文献1】

特開平11-274135号公報

【0013】

【発明が解決しようとする課題】

上記した基板処理装置では、スピンドライ方式によってウエハWの乾燥処理を行っている。この場合、ウエハWを高速で回転させて乾燥させる前にウエハW上に残っている水滴は、高速回転時にウエハWの表面上で飛散し、デバイス不良や歩留まりの低下につながるウォーターマークの形成やウエハWへのパーティクルの付着の原因となる。また、雰囲気遮断部材102の、ウエハWとの対向面（下面）に付着して残る水滴も、同様にウォーターマーク形成やパーティクル付着の原因となる。

【0014】

このため、ウエハW上および雰囲気遮断部材102の下面から水滴が完全に排除された状態で、ウエハWを高速回転させてスピン乾燥させることが重要となる。特に、雰囲気遮断部材102をスピンベース104上のウエハWに近接させた

状態で乾燥処理を行う場合には、ウエハWを高速回転させてスピン乾燥させる前に、雰囲気遮断部材102をウエハWに近接させた状態で、リンス処理後にウエハW上に残っている水滴を効率良く排除することが必要となる。

【0015】

ところで、図13および図14に示した従来の基板処理装置では、雰囲気遮断部材102の気体吐出口134が、ウエハWの中心部に対向する処理液吐出口130を取り囲むようにウエハWの回転中心を中心とした環状に形成されており、処理液吐出口130の周囲から均等にプロセスガスが吐出されるような構成となっている。また、ウエハWの下面側に対向して雰囲気遮断部材の機能を果たすスピンベース104も、同様の構成となっている。そして、薬液洗浄処理時や純水リンス処理時には、通常、処理液吐出口130、138から薬液や純水をウエハWの中心部に吐出するとともに、気体吐出口134、142から窒素ガス等のプロセスガスをウエハWの中央部に吐出し、乾燥処理中には、プロセスガスのみをウエハWの中央部に吐出するようにしている。

【0016】

図13および図14に示した構成の装置において、乾燥処理中に気体吐出口134、142からプロセスガスをウエハWの中央部に吐出したとき、ウエハWの中心付近におけるプロセスガスの流れは、図15に示したような状態となる（図15は、ウエハWの上面側だけを示しているが、ウエハWの下面側においても同様である）。図15中に破線で示すように、環状の気体吐出口134からウエハWの中央部に吐出されたプロセスガスは、ウエハWの周辺方向へ向かう流れの他にウエハWの中心Cへ向かう流れを生じる。この環状の周囲からウエハWの中心Cへ向かうプロセスガスの流れのために、ウエハWの中心部に残っている水滴が遠心力によって周辺へ拡散するのが妨げられる。特に、ウエハWの中心部では周辺部に比べて水滴に作用する遠心力が小さいため、水滴はウエハWの中心部により残り易くなる。この結果、ウエハWの中心部での乾燥が遅くなったり、ウエハWの中心部に残った水滴はウエハWの高速回転時に飛散するため、上記したウォーターマーク発生やパーティクル付着の原因になったりする。

【0017】

また、特許文献 1 に開示されているように図 16 および図 17 に示した構成の装置では、図 18 中に破線で示すように（図 18 は、ウエハ W の上面側だけを示しているが、ウエハ W の下面側においても同様である）、気体吐出口 156 からウエハ W の中心部の、ウエハ W の中心 C からずれた位置へ吐出されたプロセスガスは、ウエハ W の中心 C へ向かう勢いのある流れを生じるため、ウエハ W の中心部に残留する水滴は、プロセスガスによって周辺方向へ排除される。

【0018】

このように、図 16 および図 17 に示した構成の装置は、ウエハ W の中心部における液残りを防止するには極めて有効である。しかしながら、この装置では、ウエハ W の周辺部の水滴をプロセスガスによって除去することは困難である。プロセスガスによってウエハ W の周辺部の水滴を除去しようとする、気体吐出口 156 からウエハ W の中心部へ大流量のプロセスガスを吐出する必要があるが、この場合には、水滴が飛散して雰囲気遮断部材 148 の下面側に付着し易くなるし、必要量以上のプロセスガスを使用することとなる。したがって、気体吐出口 156 からウエハ W の中心部へプロセスガスを吐出してウエハ W 上の水滴を除去することができる範囲は限られており、特に 300 mm といった大口径ウエハに対しては、プロセスガスによってウエハ W の周辺部まで完全に水滴を除去することは極めて困難である。このように、図 16 および図 17 に示した構成の装置でも、ウエハ W を高速回転させてスピン乾燥させる前に、ウエハ W 上に残っている水滴を完全に排除することはできない。このため、上記したウォーターマークの形成やウエハへのパーティクルの付着といったことを効果的に防止することができない。

【0019】

この発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、基板を高速回転させてスピン乾燥させる前に、基板上に残っている液滴を効果的に排除することができる基板処理装置および基板処理方法を提供することを目的とする。

【0020】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、請求項 1 の発明は、回転する基板に流体を供給して

所定の処理を行う基板処理装置において、基板を保持して回転させる基板保持回転手段と、基板に対応する平面形状および大きさを有し、前記基板保持回転手段に保持された基板の少なくとも一方の面に対向し近接して配置され、基板の当該面の中央部へ処理液および気体をそれぞれ吐出する処理液吐出口および気体吐出口が形設された雰囲気遮断部材と、を備え、前記雰囲気遮断部材の、平面視で前記気体吐出口の外側に、前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面へ気体を吐出する外側気体吐出口を形設している。

【0021】

また、請求項2の発明は、請求項1の発明に係る基板処理装置において、前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気遮断部材に形設している。

【0022】

また、請求項3の発明は、請求項2の発明に係る基板処理装置において、前記到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気遮断部材に形設している。

【0023】

また、請求項4の発明は、請求項3の発明に係る基板処理装置において、前記外側気体吐出口からの気体の吐出を前記気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始している。

【0024】

また、請求項5の発明は、請求項1の発明に係る基板処理装置において、前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍となるように前記外側気体吐出口を前記雰囲気遮断部材に形設している。

【0025】

また、請求項6の発明は、請求項5の発明に係る基板処理装置において、前記気体吐出口および前記外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体を吐出してい

る。

【 0 0 2 6 】

また、請求項 7 の発明は、請求項 1 から請求項 6 のいずれかの発明に係る基板処理装置において、前記外側気体吐出口から吐出される気体の流量を、前記気体吐出口から吐出される気体の流量より大きくしている。

【 0 0 2 7 】

また、請求項 8 の発明は、請求項 1 から請求項 7 のいずれかの発明に係る基板処理装置において、平面視で前記雰囲気遮断部材を支持する支持筒の内側に前記気体吐出口および前記外側気体吐出口を配置している。

【 0 0 2 8 】

また、請求項 9 の発明は、回転する基板に流体を供給して所定の処理を行う基板処理方法において、基板保持回転手段によって基板を回転させる工程と、基板に対応する平面形状および大きさを有する雰囲気遮断部材を、基板保持回転手段に保持された基板の少なくとも一方の面に対向させ近接させて配置する工程と、前記雰囲気遮断部材に形設された処理液吐出口から前記基板保持回転手段によって回転される基板の当該面の中央部へ処理液を吐出する工程と、前記雰囲気遮断部材に形設された気体吐出口から前記基板の当該面の中央部へ気体を吐出する工程と、前記雰囲気遮断部材に平面視で前記気体吐出口の外側に形設された外側気体吐出口から前記基板の当該面へ気体を吐出する工程と、を備える。

【 0 0 2 9 】

また、請求項 1 0 の発明は、請求項 9 の発明に係る基板処理方法において、前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍となるように前記外側気体吐出口が前記雰囲気遮断部材に形設され、前記外側気体吐出口からの気体の吐出を前記気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始している。

【 0 0 3 0 】

また、請求項 1 1 の発明は、請求項 9 の発明に係る基板処理方法において、前記外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が前記基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍となるように前記外側気体吐出口が前記雰囲気遮

断部材に形設され、前記気体吐出口および前記外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体を吐出している。

【0031】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0032】

< 1. 第1実施形態 >

図1および図2は、この発明の第1実施形態を示し、図1は、基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図であり、図2は、図1のII-II矢視断面図である。基板処理装置の全体構成および基本的な処理動作については、図12に示した従来の装置と同様であるので、重複する説明を省略する。

【0033】

この基板処理装置は、基板、例えば円形の半導体ウエハWを水平姿勢に保持して回転させるスピチャック10と、このスピチャック10に保持されたウエハWの上面に対向し近接して配置される雰囲気遮断部材12とを備えている。雰囲気遮断部材12は、その平面形状がウエハWに対応する形状および大きさの円板状をなしている。

【0034】

スピチャック10は、ウエハWを上面側に保持する円板状のスピベース14と、このスピベース14の下面側中央部に垂設された円筒状の回転筒16とから構成されている。スピベース14の上面側周縁部には、ウエハWの周縁部を把持してウエハWをスピベース14の上面から離間させた状態で保持する3本以上のチャックピン18が、円周方向に等配されて植設されている。回転筒16は、図示しない回転駆動機構によって鉛直方向の軸心線回りに回転させられ、回転筒16が回転することにより、スピベース14と共にウエハWが回転するようになっている。回転筒16の中空部には、細長い円柱状の内挿軸20が挿通されている。内挿軸20は、固定されて立設されており、内挿軸20と回転筒16とは同心に配置され、内挿軸20の外周面と回転筒16の内周面との間にベアリング（図示せず）が介在して取着されている。また、内挿軸20の軸心部には

、薬液や純水などの処理液の通路となる処理液供給路 22 が形設されており、その処理液供給路 22 の、スピンベース 14 上に保持されたウエハ W の下面と対向する上端が処理液吐出口 24 となる。

【0035】

雰囲気遮断部材 12 は、円筒状の回転支持筒 26 の下端に接続されている。回転支持筒 26 の中空部には、細長い円柱状の内挿軸 28 が挿通されており、内挿軸 28 と回転支持筒 26 とは同心に配置され、内挿軸 28 の外周面と回転支持筒 26 の内周面との間にベアリング（図示せず）が介在して取付されている。回転支持筒 26 は、図示していないが、支持アームの先端部に懸垂状態で、かつ、モータによって鉛直方向の軸心線回りに回転可能に支持されており、回転支持筒 26 が回転させられることにより、雰囲気遮断部材 12 が回転支持筒 26 と共に回転するようになっている。また、回転支持筒 26 は、昇降駆動装置によって上下方向へ往復移動させられるように構成されており、回転支持筒 26 が上下方向へ往復移動することにより、雰囲気遮断部材 12 がスピンベース 14 上のウエハ W の上面に対して近接および離間するようになっている。

【0036】

回転支持筒 26 の中空部に挿通された内挿軸 28 には、薬液や純水などの処理液の通路となる処理液供給路 30 が形設されており、その処理液供給路 30 の、スピンベース 14 上に保持されたウエハ W の上面と対向する下端が処理液吐出口 32 となる。また、内挿軸 28 には、処理液供給路 30 の側方に並んで、窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどのプロセスガスの通路となる気体供給路 34 が形設されており、その気体供給路 34 の下端が気体吐出口 36 となる。気体吐出口 36 は、雰囲気遮断部材 12 の、ウエハ W の上面との対向面に形設され、処理液吐出口 32 に隣接して開口している。気体供給路 34 の内径寸法は、処理液供給路 30 の内径寸法より大きくされている。なお、図示例では、処理液供給路 30 および気体供給路 34 はいずれも、内挿軸 28 の軸心から軸心がずれるように、したがってスピンベース 14 上に保持されたウエハ W の中心に対して偏心して形成されているが、処理液供給路 30 または気体供給路 34 を内挿軸 28 と同心に形成するようにしてもよい。

【0037】

この装置では、さらに、内挿軸 28 の外周面と回転支持筒 26 の内周面との間に形成される空間部分が外側気体供給路 38 を構成し、その外側気体供給路 38 の下端が、環状の外側気体吐出口 40 となっている。すなわち、雰囲気遮断部材 12 には、ウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出する気体吐出口 36 の他に、平面視でその気体吐出口 36 の外側に外側気体吐出口 40 が、気体吐出口 36 の周囲を環状に取り囲むように設けられている。また、図 1 および図 2 に示すように、平面視で雰囲気遮断部材 12 を支持する回転支持筒 26 の内側に気体吐出口 36 および外側気体吐出口 40 の双方が配置されている。

【0038】

第 1 実施形態では、外側気体吐出口 40 がウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出する気体吐出口 36 の外側に近接して設けられている。このため、外側気体吐出口 40 から吐出される気体の到達位置もスピンドル 14 上に保持されたウエハ W の上面の中心近傍となる。

【0039】

雰囲気遮断部材 12 の気体吐出口 36 および外側気体吐出口 40 からのプロセスガスの吐出は、ウエハ W の薬液洗浄処理および純水リンス処理が終わった後、ウエハ W を高速で回転させるスピン乾燥処理を行う前に行う。このとき、雰囲気遮断部材 12 の気体吐出口 36 からウエハ W の上面の中央部へプロセスガスが吐出されることにより、ウエハ W の上面の中央部に残っている水滴がウエハ W の周辺部へ拡散してウエハ W の中央部から排除される。また、雰囲気遮断部材 12 の外側気体吐出口 40 からウエハ W の上面の中心近傍へプロセスガスが吐出されることにより、ウエハ W の上面の周辺部に残っている水滴や中央部から周辺部へ拡散してきた水滴が、ウエハ W の周辺部から外周方向へ拡散して周辺部から排除される。このようにして、ウエハ W 上に残っている全ての水滴が排除される。そして、この装置では、気体吐出口 36 からウエハ W の中心部へ大流量のプロセスガスを吐出する必要が無いので、水滴がウエハ W の上面で跳ね返って飛散し雰囲気遮断部材 12 の下面側に付着する、といった心配が無いし、必要量以上のプロセスガスを使用することもない。なお、必要に応じて、薬液洗浄処理および／また

は純水リンス処理の際に、気体吐出口 36 からウエハ W の上面の中央部に向けてプロセスガスを吐出させる。また、続いて行われるスピン乾燥時には、気体吐出口 36 および外側気体吐出口 40 からプロセスガスを引き続き吐出したままにする。

【0040】

外側気体吐出口 40 から吐出されるプロセスガスの流量は、通常、気体吐出口 36 から吐出されるプロセスガスの流量より大きくされる。また、第 1 実施形態の如く、外側気体吐出口 40 からウエハ W の上面の中心近傍へプロセスガスが吐出されるように、雰囲気遮断部材 12 に外側気体吐出口 40 を配置したときは、通常図 3 に示すように、気体吐出口 36 および外側気体吐出口 40 からほぼ同時にそれぞれ気体が吐出されるようにする。そして、このときは、各吐出口 36、40 から吐出されるプロセスガスの流量バランスを適正に調整することにより、気体吐出口 36 から吐出されるプロセスガスによってウエハ W の上面の中央部から液滴が排除されるとともに、外側気体吐出口 40 から吐出されるプロセスガスによってウエハ W の周辺部から液滴が除去されるようにする。例えば、プロセスガスを 100 l/min の流量でウエハ W の上面へ吐出する場合、気体吐出口 36 からは 20 l/min の流量でプロセスガスを吐出し、外側気体吐出口 40 からは 80 l/min の流量でプロセスガスを吐出するようにする。

【0041】

< 2. 第 2 実施形態 >

次に、本発明の第 2 実施形態について説明する。図 4 は、第 2 実施形態の基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図であり、図 5 は、図 4 の IV-IV 矢視断面図である。図 4 において図 1 と同一符号を付した部材は、図 1 に関して説明したものと同一の機能を有する同一部材であり、それらについての説明は省略する。また、第 1 実施形態と同様に、基板処理装置の全体構成および基本的な処理動作については、図 12 に示した従来の装置と同様であるので、重複する説明を省略する。

【0042】

第 1 実施形態の基板処理装置と同様に、スピンチャック 10 に保持されたウエ

ハWの上面に対向し近接して配置される雰囲気遮断部材82は、円筒状の回転支持筒86の下端に接続されている。回転支持筒86の中空部には、円柱状の内挿軸88が挿通されており、内挿軸88と回転支持筒86とは同心に配置され、内挿軸88の外周面と回転支持筒86の内周面との間にベアリング（図示せず）が介在して取着されている。回転支持筒86は、図示を省略する支持アームの先端部に懸垂状態で、かつ、モータによって鉛直方向の軸心線回りに回転可能に支持されており、回転支持筒86が回転させられることにより、雰囲気遮断部材82が回転支持筒86と共に回転するようになっている。また、回転支持筒86は、昇降駆動装置によって上下方向へ往復移動させられるように構成されており、回転支持筒86が上下方向へ往復移動することにより、雰囲気遮断部材82がスピンドルベース14上のウエハWの上面に対して近接および離間するようになっている。

【0043】

回転支持筒86の中空部に挿通された内挿軸88には、薬液や純水などの処理液の通路となる処理液供給路90が形設されており、その処理液供給路90の、スピンドルベース14上に保持されたウエハWの上面と対向する下端が処理液吐出口92となる。また、内挿軸88には、処理液供給路90の側方に並んで、窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどのプロセスガスの通路となる気体供給路94が形設されており、その気体供給路94の下端が気体吐出口96となる。気体吐出口96は、雰囲気遮断部材82の、ウエハWの上面との対向面に形設され、処理液吐出口92に隣接して開口している。気体供給路94の内径寸法は、処理液供給路90の内径寸法より大きくされている。なお、図示例では、処理液供給路90および気体供給路94はいずれも、内挿軸88の軸心から軸心がずれるように、したがってスピンドルベース14上に保持されたウエハWの中心に対して偏心して形成されているが、処理液供給路90または気体供給路94を内挿軸88と同心に形成するようにしてもよい。

【0044】

第2実施形態の装置でも、さらに、内挿軸88の外周面と回転支持筒86の内周面との間に形成される空間部分が外側気体供給路98を構成し、その外側気体

供給路 98 の下端が、環状の外側気体吐出口 99 となっている。すなわち、雰囲気遮断部材 82 には、ウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出する気体吐出口 96 の他に、平面視でその気体吐出口 36 の外側に外側気体吐出口 99 が、気体吐出口 96 の周囲を環状に取り囲むように設けられている。また、図 4 および図 5 に示すように、平面視で雰囲気遮断部材 82 を支持する回転支持筒 86 の内側に気体吐出口 96 および外側気体吐出口 99 の双方が配置されている。

【0045】

第 2 実施形態では、外側気体吐出口 99 がウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出する気体吐出口 36 から離間して設けられている。具体的には、外側気体吐出口 99 から吐出される気体の到達位置がスピンベース 14 に保持されたウエハ W の上面の中心と外周端縁との中間近傍となるように、外側気体吐出口 99 が雰囲気遮断部材 82 に形設されている。

【0046】

雰囲気遮断部材 82 の気体吐出口 96 および外側気体吐出口 99 からのプロセスガスの吐出は、ウエハ W の薬液洗浄処理および純水リンス処理が終わった後、ウエハ W を高速で回転させてスピン乾燥処理を行う前に行う。このとき、雰囲気遮断部材 82 の気体吐出口 96 からウエハ W の上面の中央部へプロセスガスが吐出されることにより、ウエハ W の上面の中央部に残っている水滴がウエハ W の周辺部へ拡散してウエハ W の中央部から排除される。また、雰囲気遮断部材 82 の外側気体吐出口 99 からウエハ W の上面へプロセスガスが吐出されることにより、ウエハ W の上面の周辺部に残っている水滴や中央部から周辺部へ拡散してきた水滴が、ウエハ W の周辺部から外周方向へ拡散して周辺部から排除される。このようにして、ウエハ W 上に残っている全ての水滴が排除される。そして、この装置では、気体吐出口 96 からウエハ W の中心部へ大流量のプロセスガスを吐出する必要が無いので、水滴がウエハ W の上面で跳ね返って飛散し雰囲気遮断部材 82 の下面側に付着する、といった心配が無いし、必要量以上のプロセスガスを使用することもない。なお、必要に応じて、薬液洗浄処理および／または純水リンス処理の際に、気体吐出口 96 からウエハ W の上面の中央部に向けてプロセスガスを吐出させる。また、続いて行われるスピン乾燥時には、気体吐出口 96 およ

び外側気体吐出口 9 9 からプロセスガスを引き続き吐出したままにする。

【 0 0 4 7 】

第 1 実施形態と同様に、外側気体吐出口 9 9 から吐出されるプロセスガスの流量は、通常、気体吐出口 9 6 から吐出されるプロセスガスの流量より大きくされる。また、第 2 実施形態の如く、外側気体吐出口 9 9 からウエハ W の上面の中心と外周端縁との中間近傍にプロセスガスが吐出されるように、雰囲気遮断部材 8 2 に外側気体吐出口 9 9 を配置したときは、通常、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出より遅れて外側気体吐出口 9 9 からのプロセスガスの吐出が開始されるように制御する。すなわち、図 6 (a) に示すように、まず、気体吐出口 9 6 からウエハ W の上面の中央部へプロセスガスを、例えば 20 l/min の流量で吐出し、ウエハ W の上面の中央部に残っている純水 1 をウエハ W の周辺部へ拡散させてウエハ W の中央部から排除する。このときに、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出によって、純水 1 はウエハ W の上面の中心と外周端縁との中間付近まで押し出される。

【 0 0 4 8 】

続いて、図 3 (b) に示すように、外側気体吐出口 9 9 からウエハ W の上面の中心と外周端縁との中間近傍へプロセスガスを、例えば 80 l/min の流量で吐出し、ウエハ W の上面の中央部から上記中間近傍にまで押し出されてきた純水 1 を、元々周辺部に残っている純水と共にウエハ W の周辺部から外周方向へ拡散させて周辺部から排除する。なお、外側気体吐出口 9 9 からのプロセスガスの吐出を開始した後は、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出を停止させてもよいし、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出を続けて行ってもよいし、また、外側気体吐出口 9 9 からのプロセスガスの吐出を開始してから所定時間が経過した時点で、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出だけを停止させるようにしてもよい。

【 0 0 4 9 】

第 2 実施形態では、気体吐出口 9 6 からのプロセスガスの吐出によって、中央部の純水 1 がウエハ W の上面の中心と外周端縁との中間付近まで押し出される。そして、その中間近傍に外側気体吐出口 9 9 からプロセスガスを吐出している。

つまり、気体吐出口 96 からのプロセスガス吐出によって純水 1 を排除できる限界の位置に外側気体吐出口 99 からプロセスガスを吐出しているのである。このため、第 1 実施形態に比較して外側気体吐出口 99 からのプロセスガス吐出による純水排除効果が大きく、効率良く純水をウエハ W の周辺部から外周方向へ飛散させることができる。

【0050】

< 3. 第 3 実施形態 >

次に、本発明の第 3 実施形態について説明する。図 7 は、第 3 実施形態の基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図であり、図 8 は、図 7 の V-V 矢視断面図である。図 7 において図 1 と同一符号を付した部材は、図 1 に関して説明したものと同一の機能を有する同一部材であり、それらについての説明は省略する。

【0051】

第 1 実施形態の基板処理装置と同様に、スピンチャック 10 に保持されたウエハ W の上面に対向し近接して配置される雰囲気遮断部材 42 は、円筒状の回転支持筒 44 の下端に接続されており、回転支持筒 44 の中空部に、細長い円柱状の内挿軸 46 が挿通されている。内挿軸 46 と回転支持筒 44 とは同心に配置され、回転支持筒 44 は鉛直方向の軸心線回りに回転可能に支持されていて、雰囲気遮断部材 42 は、回転支持筒 44 と共に回転するようになっている。これ以外の基本的な構成も、図 1 および図 2 に示した第 1 実施形態の基板処理装置と同様である。

【0052】

第 3 実施形態の基板処理装置においても、回転支持筒 44 の中空部に挿通された内挿軸 46 に、薬液や純水などの処理液の通路となる処理液供給路 48 が形設されており、その処理液供給路 48 の、スピンベース 14 上に保持されたウエハ W の上面と対向する下端が処理液吐出口 50 となる。また、内挿軸 46 には、処理液供給路 48 の側方に並んで、窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどのプロセスガスの通路となる気体供給路 52 が形設されており、その気体供給路 52 の下端が気体吐出口 54 となる。気体吐出口 54 は、雰囲気遮断部材 42 の、ウエハ W の上面との対向面に形設され、処理液吐出口 50 に隣接して開口してい

る。気体供給路 52 は、内挿軸 46 と同心に形成されており、気体吐出口 54 からスピンベース 14 上に保持されたウエハ W の中心部に向けてプロセスガスが吐出されるようになっている。この気体供給路 52 の内径寸法は、処理液供給路 48 の内径寸法より大きくされている。

【0053】

また、この装置では、回転支持筒 44 の、内挿軸 46 に形成された気体供給路 52 の軸心を中心とした円周上の位置に、複数本の外側気体供給路 56 が、円周方向に等配されてそれぞれ気体供給路 52 の軸心線と平行に形設されている。そして、複数本の外側気体供給路 56 のそれぞれの下端が外側気体吐出口 58 となっており、雰囲気遮断部材 42 の、ウエハ W の上面との対向面に、複数個の外側気体吐出口 58 が、円周方向に等配されて気体吐出口 54 を取り囲むようにそれぞれ開口している。

【0054】

この基板処理装置における雰囲気遮断部材 42 の気体吐出口 54 および複数個の外側気体吐出口 58 からのプロセスガスの吐出も、第 1 実施形態の装置と同様に行われ、同様の作用効果が奏される。

【0055】

図 9 は、複数個の外側気体吐出口 58 からのプロセスガスの吐出を、気体吐出口 54 からのプロセスガスの吐出より遅れて開始するようにしたときの状態を示す図である。図 9 (a) に示すように、まず、気体吐出口 54 からウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出し、ウエハ W の上面の中央部に残っている純水 1 をウエハ W の周辺部へ拡散させてウエハ W の中央部から排除する。続いて、図 6 (b) に示すように、複数個の外側気体吐出口 58 からウエハ W の上面へプロセスガスを吐出し、ウエハ W の上面の中央部から周辺部へ拡散してきた純水 1 を、元々周辺部に残っている純水と共にウエハ W の周辺部から外周方向へ拡散させて周辺部から排除する。このとき、外側気体吐出口 58 からのプロセスガスの吐出を開始した後に、気体吐出口 54 からのプロセスガスの吐出を停止させてもよいし、気体吐出口 54 からのプロセスガスの吐出を継続させてもよいし、また、外側気体吐出口 58 からのプロセスガスの吐出を開始してから所定時間が経過し

た時点で気体吐出口 54 からのプロセスガスの吐出だけを停止させるようにしてもよい。

【0056】

< 4. 第 4 実施形態 >

次に、本発明の第 4 実施形態について説明する。図 10 は、第 4 実施形態の基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図である。図 10 において図 1 と同一符号を付した部材は、図 1 に関して説明したものと同一の機能を有する同一部材であり、それらについての説明は省略する。

【0057】

この基板処理装置は、図 7 および図 8 に示した装置と同様に、回転支持筒 64 の中空部に挿通された内挿軸 66 に、薬液や純水などの処理液の通路となる処理液供給路 68 が形設されており、その処理液供給路 68 の、スピンベース 14 上に保持されたウエハ W の上面と対向する下端が処理液吐出口 70 となる。また、内挿軸 66 には、処理液供給路 68 の側方に並んで、窒素ガス等の不活性ガスやドライエアーなどのプロセスガスの通路となる気体供給路 72 が形設されており、その気体供給路 72 の下端が気体吐出口 74 となる。気体吐出口 74 は、雰囲気気遮断部材 62 の、ウエハ W の上面との対向面に形設され、処理液吐出口 70 に隣接して開口している。気体供給路 72 は、内挿軸 66 と同心に形成されており、気体吐出口 74 からスピンベース 14 上に保持されたウエハ W の中心部に向けてプロセスガスが吐出されるようになっている。この気体供給路 72 の内径寸法は、処理液供給路 68 の内径寸法より大きくされている。

【0058】

また、この装置でも、回転支持筒 64 の、内挿軸 66 に形成された気体供給路 72 の軸心を中心とした円周上の位置に、複数本の外側気体供給路 76a が、円周方向に等配されてそれぞれ気体供給路 72 の軸心線と平行に形設されている。そして、この装置では、各外側気体供給路の下端部 76b が、それぞれ下方外向きに傾斜して平面視で放射状に雰囲気気遮断部材 62 に形設されている。そして、複数本の外側気体供給路の下端部 76b のそれぞれの出口が外側気体吐出口 78 となっており、雰囲気気遮断部材 62 の、ウエハ W の上面との対向面に、複数個の

外側気体吐出口 78 がそれぞれ開口している。複数個の外側気体吐出口 78 は、円周方向に等配されて気体吐出口 74 を取り囲むように設けられているが、図 7 および図 8 に示した装置における外側気体吐出口 58 に比べて、雰囲気遮断部材 62 のより周縁寄りに形成されている。

【0059】

この基板処理装置における雰囲気遮断部材 62 の気体吐出口 74 および複数個の外側気体吐出口 78 からのプロセスガスの吐出も、図 7 および図 8 に示した装置と同様に行われ、同様の作用効果が奏される。

【0060】

図 11 は、複数個の外側気体吐出口 78 からのプロセスガスの吐出を、気体吐出口 74 からのプロセスガスの吐出より遅れて開始するようにしたときの状態を示す図である。図 11 (a) に示すように、まず、気体吐出口 74 からウエハ W の上面の中心部へプロセスガスを吐出し、ウエハ W の上面の中央部に残っている純水 1 をウエハ W の周辺部へ拡散させてウエハ W の中央部から排除する。続いて、図 11 (b) (図 11 (b) では、雰囲気遮断部材 62 の片側だけを示している。) に示すように、複数個の外側気体吐出口 78 からウエハ W の上面へプロセスガスを吐出し、ウエハ W の上面の中央部から周辺部へ拡散してきた純水 1 を、元々周辺部に残っている純水と共にウエハ W の周辺部から外周方向へ拡散させて周辺部から排除する。この際、複数個の外側気体吐出口 78 からは、ウエハ W の上面に対してそれぞれ斜め方向へ外向きにプロセスガスが吐出されるので、より少ないガス流量で効率良くウエハ W の上面の周辺部から純水 1 を排除することができる。なお、この装置でも、外側気体吐出口 78 からのプロセスガスの吐出を開始した後に、気体吐出口 74 からのプロセスガスの吐出を停止させてもよいし、気体吐出口 74 からのプロセスガスの吐出を継続させてもよいし、また、外側気体吐出口 78 からのプロセスガスの吐出を開始してから所定時間が経過した時点で気体吐出口 74 からのプロセスガスの吐出だけを停止させるようにしてもよい。

【0061】

< 5. 変形例 >

以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記の例に限定されるものではない。例えば、上記各実施形態では、スピンチャックのスピンベース、回転筒および内挿軸の構成を、雰囲気遮断部材、その回転支持筒および内挿軸の構成とは異なるものになっているが、図13および図16にそれぞれ示した装置のように、スピンチャックのスピンベース、回転筒および内挿軸の構成を雰囲気遮断部材、その回転支持筒および内挿軸の構成と同様のものとし、スピンベースが、それに保持されたウエハWの下面に対し雰囲気遮断部材としての機能を十分に果たすようにしてもよい。

【0062】

また、上記第1実施形態においては外側気体吐出口40からウエハWの上面の中心近傍へプロセスガスが吐出され、第2実施形態においては外側気体吐出口99からウエハWの上面の中心と外周端縁との中間近傍にプロセスガスが吐出されていたが、これに限定されるものではなく、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置がスピンベース14に保持されたウエハWの上面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるように、外側気体吐出口を雰囲気遮断部材に形設するようにすれば良い。このようにすれば、少なくとも第1実施形態と同様の効果を得ることができる。

【0063】

また、上記第3実施形態および第4実施形態の外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置についてもスピンベース14に保持されたウエハWの上面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるように、外側気体吐出口を雰囲気遮断部材に形設するようにすれば良い。特に、第4実施形態の外側気体吐出口58から吐出される気体の到達位置をスピンベース14に保持されたウエハWの上面の中心と外周端縁との中間近傍となるようにすれば、気体吐出口74からのプロセスガス吐出によって純水1を排除できる限界の位置に対して斜め方向へ外向きに外側気体吐出口58からプロセスガスが吐出されるので、より少ないガス流量で効率良くウエハWの上面の周辺部から純水1を排除することができる。

【0064】

また、プロセスガスの吐出フロー形態としては、薬液洗浄処理および／または

純水リンス処理の際に気体吐出口および外側気体吐出口の双方からプロセスガスを吐出するようにしても良い。

【0 0 6 5】

例えば、第 1 実施形態において、薬液洗浄処理および／または純水リンス処理の際に気体吐出口 3 6 からウエハ W の上面の中央部に向けてプロセスガスを吐出させるとともに、外側気体吐出口 4 0 からもプロセスガスの吐出を行うようにしてもよい。

【0 0 6 6】

こうすることで、口径が小さく吐出量が制限される気体吐出口 3 6 からのプロセスガスの吐出を外側気体吐出口 4 0 に分担させて、より早く雰囲気置換を行うことができ、更に、気体吐出口 3 6 の負荷を軽減することができる。

【0 0 6 7】

次に、ウエハ W の薬液洗浄処理および純水リンス処理が終わった後、ウエハ W を高速で回転させるスピン乾燥処理を行う前に、薬液洗浄処理および／または純水リンス処理の際の吐出流量よりも多くして気体吐出口 3 6 および外側気体吐出口 4 0 からのプロセスガスの吐出を行う。

【0 0 6 8】

また、気体吐出口と外側気体吐出口との間の流量配分は 20 l/min と 80 l/min に限定されるものではなく、例えば、ウエハ W の上面へ吐出するプロセスガスの総流量は 100 l/min として、気体吐出口 3 6 から 40 l/min の流量でプロセスガスを吐出し、外側気体吐出口 4 0 から 60 l/min の流量でプロセスガスを吐出するようにしても良い。

【0 0 6 9】

すなわち、上記第 1 実施形態より気体吐出口 3 6 からのプロセスガスの流量を多くすることで、外側気体吐出口 4 0 からのプロセスガスの吐出タイミングを早めるようにしても良い。

【0 0 7 0】

【発明の効果】

以上説明したように、請求項 1 の発明によれば、気体吐出口からの気体吐出に

よって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴がさらに気体吐出口の外側に設けられた外側気体吐出口からの気体吐出によって該周辺部からも排除されるため、基板を高速回転させてスピン乾燥させる前に、基板上に残っている液滴を効果的に排除することができ、その結果デバイス不良や歩留まりの低下につながるウォーターマークの形成や基板へのパーティクルの付着を有効に防止することができる。

【0071】

また、請求項2の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴をより効果的に排除することができる。

【0072】

また、請求項3の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍となるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴をより効果的に排除することができる。

【0073】

また、請求項4の発明によれば、外側気体吐出口からの気体の吐出が気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始されるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴をより効果的に排除することができる。

【0074】

また、請求項5の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍となるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から押し出された液滴を基板の周辺部からも排除することができる。

【0075】

また、請求項6の発明によれば、気体吐出口および外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体が吐出されるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の

中央部から押し出された液滴を基板の周辺部からも効果的に排除することができる。

【0076】

また、請求項7の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の流量が気体吐出口から吐出される気体の流量より大きいため、基板の周辺部からも液滴を確実に排除することができる。

【0077】

また、請求項8の発明によれば、平面視で雰囲気遮断部材を支持する支持筒の内側に気体吐出口および外側気体吐出口を配置しているため、装置構成をコンパクトなものとすることができる。

【0078】

また、請求項9の発明によれば、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴がさらに気体吐出口の外側に設けられた外側気体吐出口からの気体吐出によって該周辺部からも排除されるため、基板を高速回転させてスピン乾燥させる前に、基板上に残っている液滴を効果的に排除することができ、その結果デバイス不良や歩留まりの低下につながるウォーターマークの形成や基板へのパーティクルの付着を有効に防止することができる。

【0079】

また、請求項10の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心と外周端縁との中間近傍とされ、外側気体吐出口からの気体の吐出が気体吐出口からの気体の吐出より遅れて開始されるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から周辺部に押し出された液滴をより効果的に排除することができる。

【0080】

また、請求項11の発明によれば、外側気体吐出口から吐出される気体の到達位置が基板保持回転手段に保持された基板の当該面の中心近傍とされ、気体吐出口および外側気体吐出口からほぼ同時にそれぞれ気体が吐出されるため、気体吐出口からの気体吐出によって基板の中央部から押し出された液滴を基板の周辺部からも効果的に排除することができる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

この発明の第 1 実施形態の基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図である。

【図 2】

図 1 の II－II 矢視断面図である。

【図 3】

図 1 および図 2 に示した装置の作用を説明するための要部縦断面図である。

【図 4】

第 2 実施形態の基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図である。

【図 5】

図 4 の IV－IV 矢視断面図である。

【図 6】

図 4 および図 5 に示した装置の作用を説明するための要部縦断面図である。

【図 7】

第 3 実施形態の基板処理装置の要部を構成を示す縦断面図である。

【図 8】

図 7 の V－V 矢視断面図である。

【図 9】

図 7 および図 8 に示した装置の作用を説明するための要部縦断面図である。

【図 1 0】

第 4 実施形態の基板処理装置の要部を構成を示す縦断面図である。

【図 1 1】

図 1 0 に示した装置の作用を説明するための要部縦断面図である。

【図 1 2】

従来の基板処理装置の全体構成の一例を示し、一部を省略した概略正面図である。

【図 1 3】

図 1 2 に示した基板処理装置の要部の構成を示す縦断面図である。

【図 1 4】

図 1 3 の XI-XI 矢視断面図である。

【図 1 5】

図 1 3 および図 1 4 に示した従来の装置における問題点を説明するための要部縦断面図である。

【図 1 6】

従来の基板処理装置の別の構成例を示し、その要部の構成を示す縦断面図である。

【図 1 7】

図 1 6 の XIV-XIV 矢視断面図である。

【図 1 8】

図 1 6 および図 1 7 に示した装置の作用を説明するための要部縦断面図である。

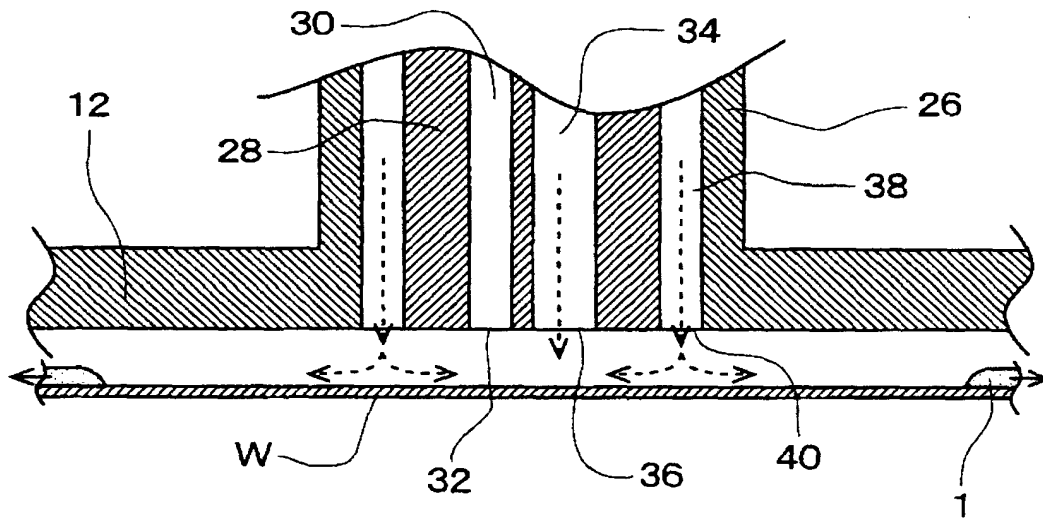
【符号の説明】

- 1 0 スピンチャック
- 1 2、4 2、6 2 雰囲気遮断部材
- 1 4 スピンベース
- 1 6 回転筒
- 1 8 チャックピン
- 2 0 回転筒の内挿軸
- 2 2 回転筒の内挿軸の処理液供給路
- 2 4 スピンベースの処理液吐出口
- 2 6、4 4、6 4、8 6 回転支持筒
- 2 8、4 6、6 6、8 8 回転支持筒の内挿軸
- 3 0、4 8、6 8、9 0 処理液供給路
- 3 2、5 0、7 0、9 2 処理液吐出口
- 3 4、5 2、7 2、9 4 気体供給路
- 3 6、5 4、7 4、9 6 気体吐出口
- 3 8、5 6、7 6 a、9 8 外側気体供給路
- 4 0、5 8、7 8、9 9 外側気体吐出口

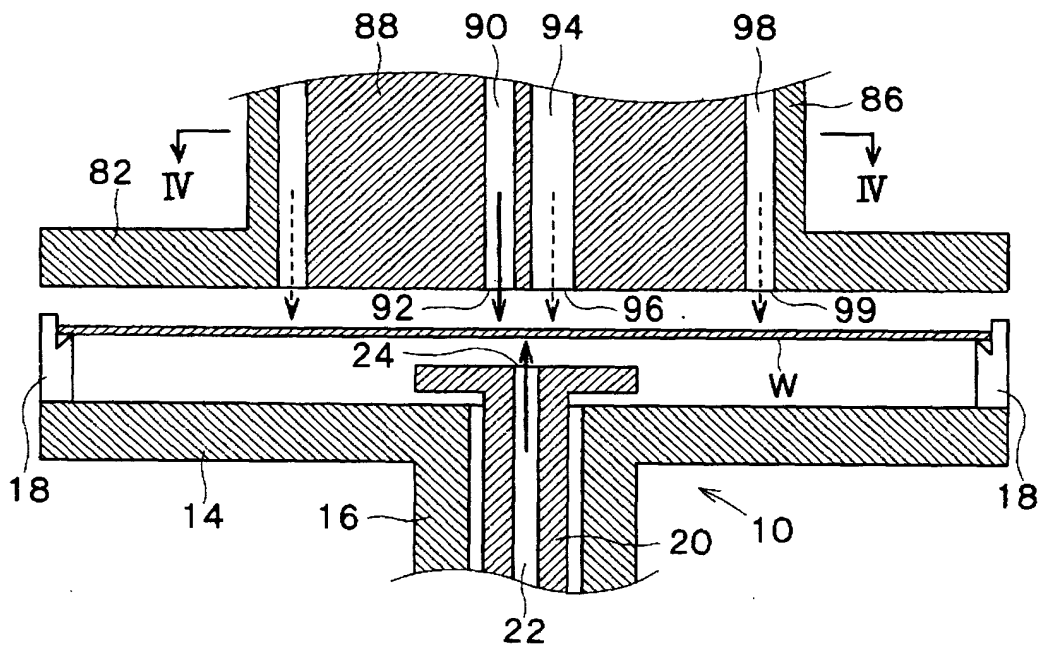
7 6 b 外側気体供給路の下端部

W 半導体ウエハ

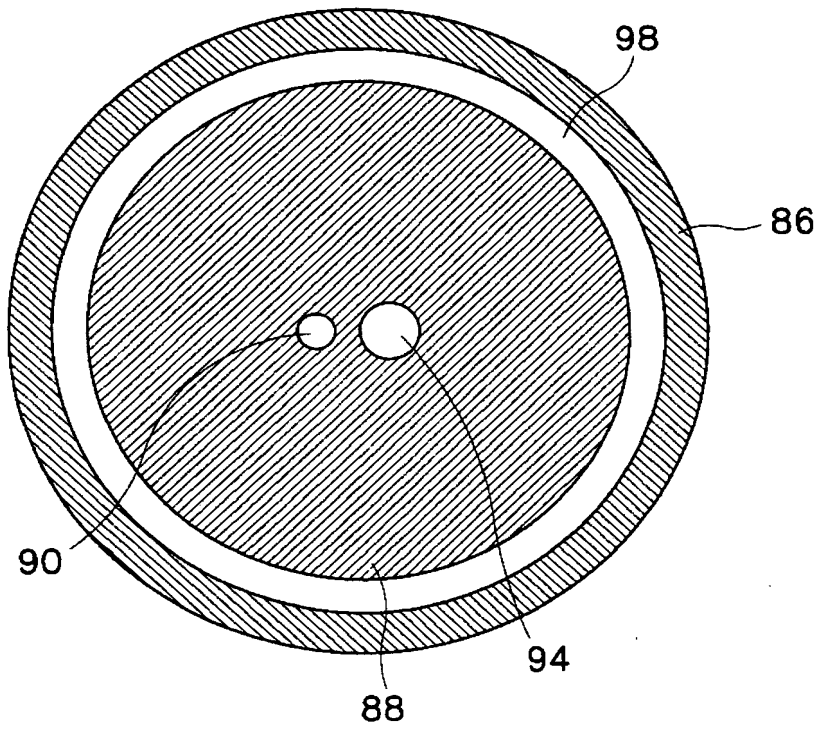
【図3】



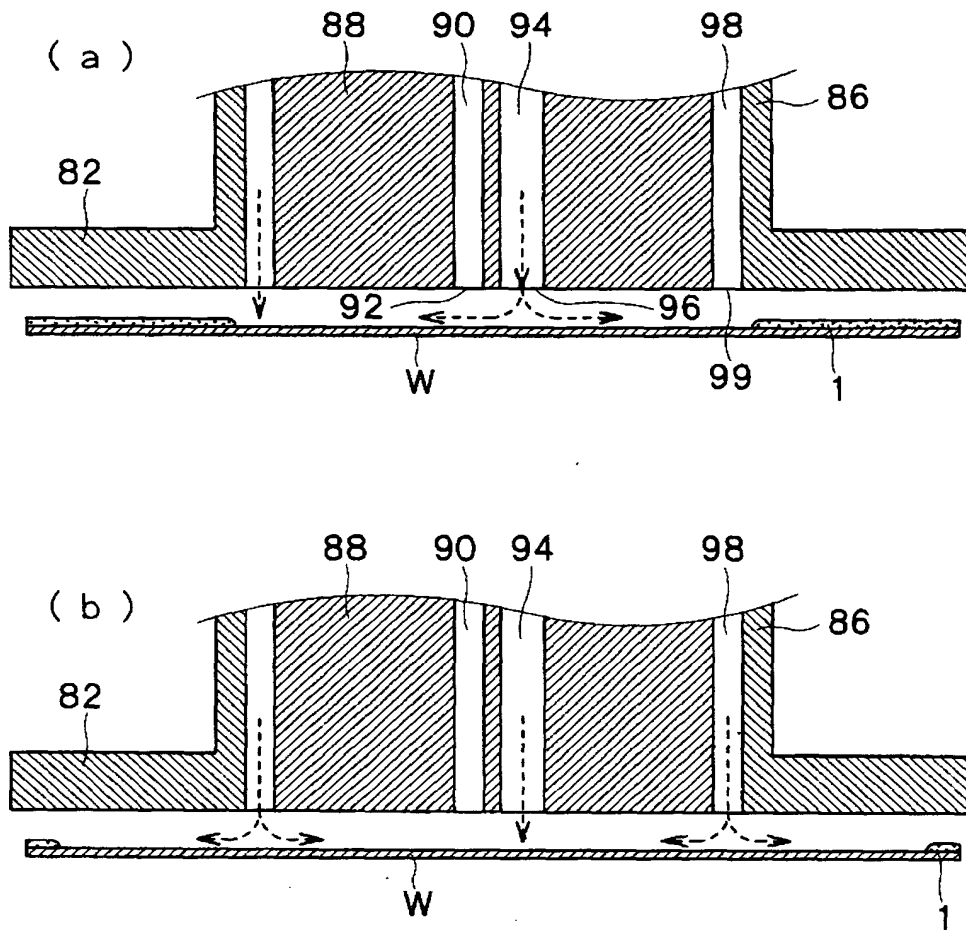
【図4】



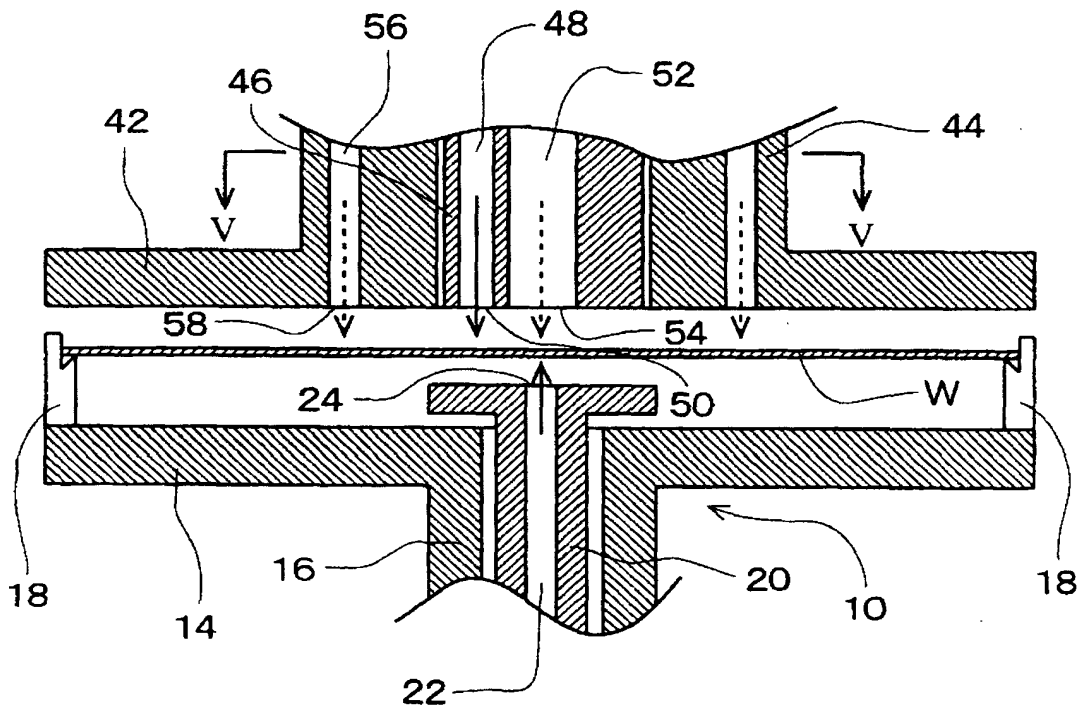
【図 5】



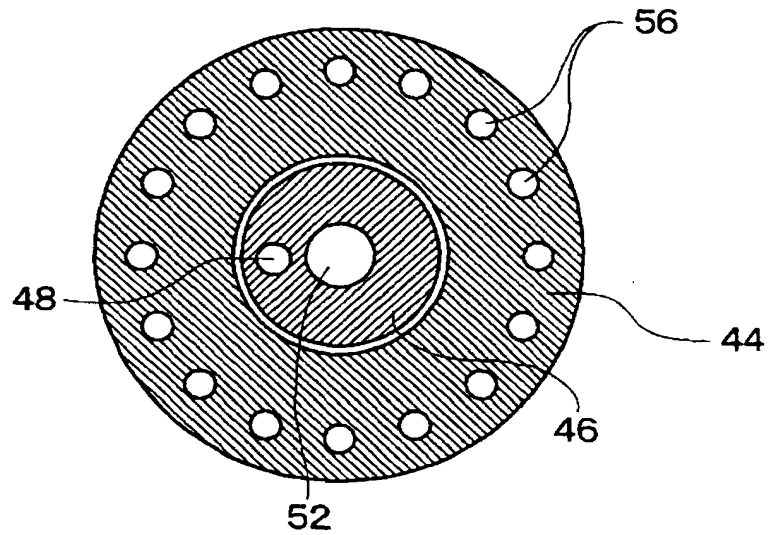
【図 6】



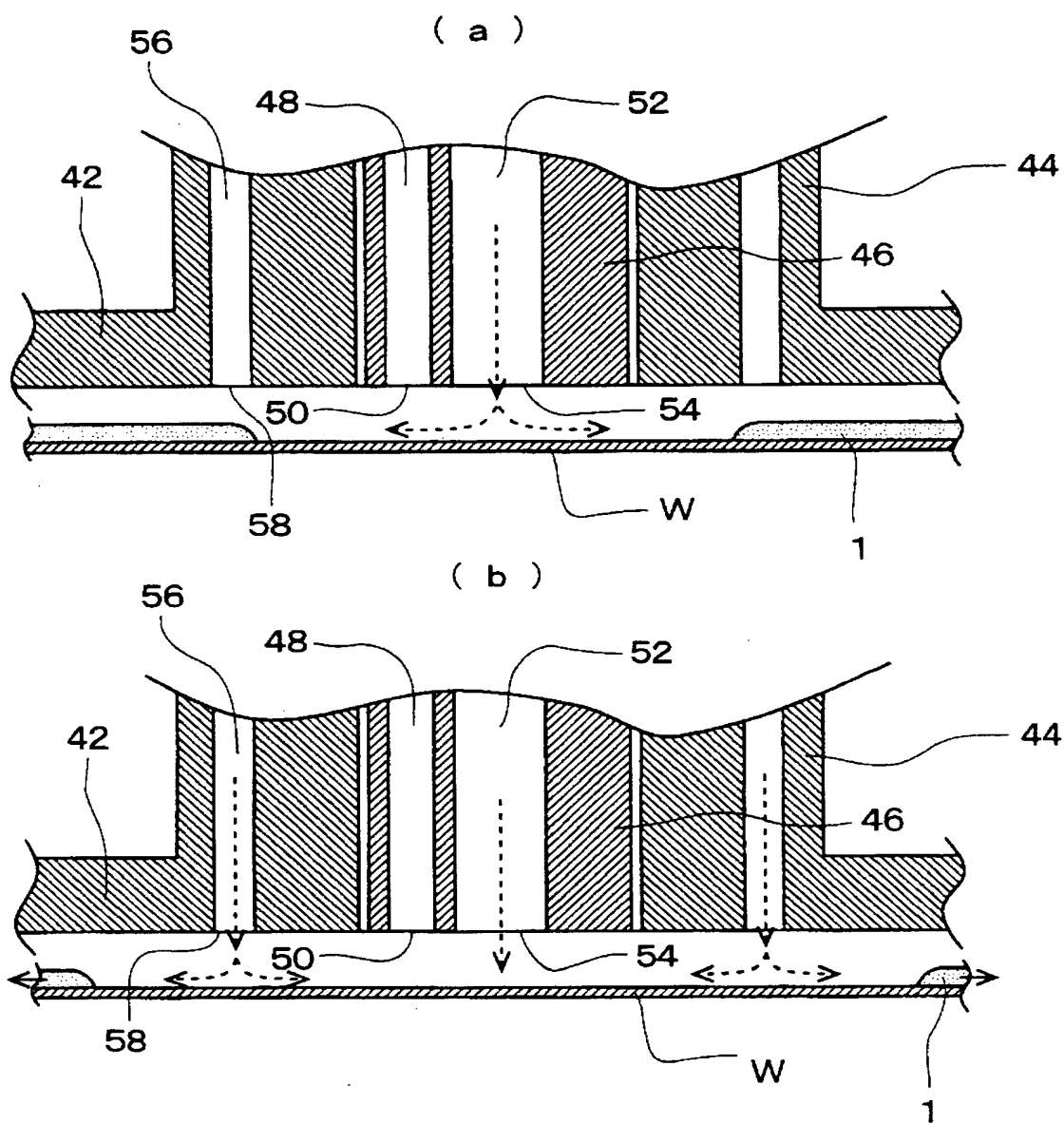
【図 7】



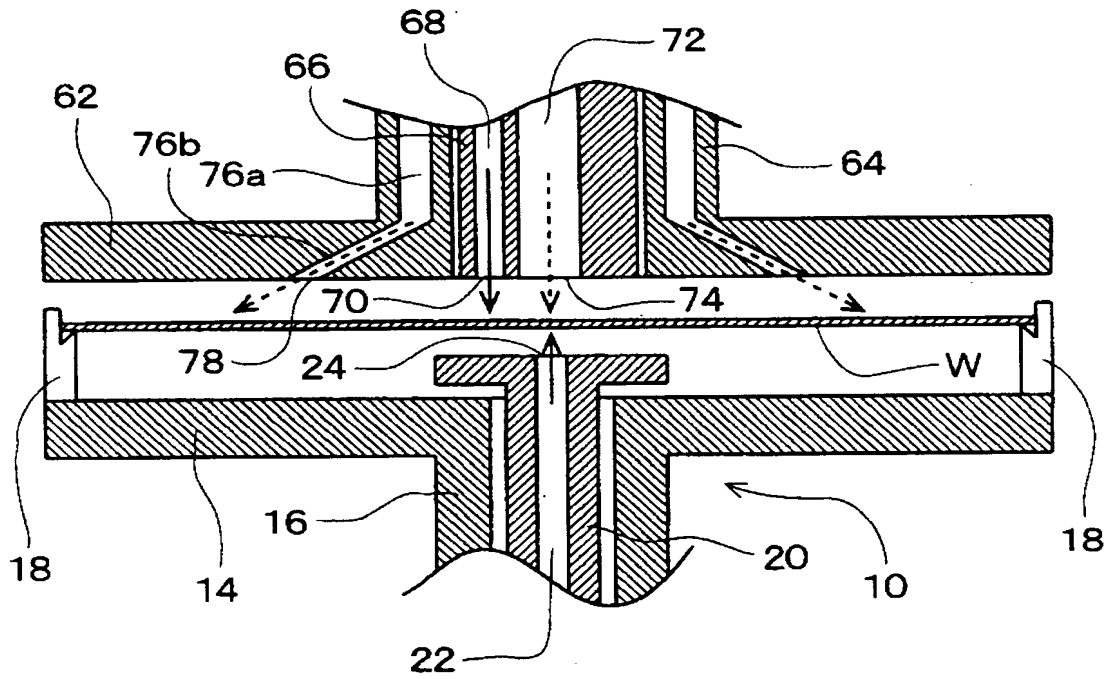
【図 8】



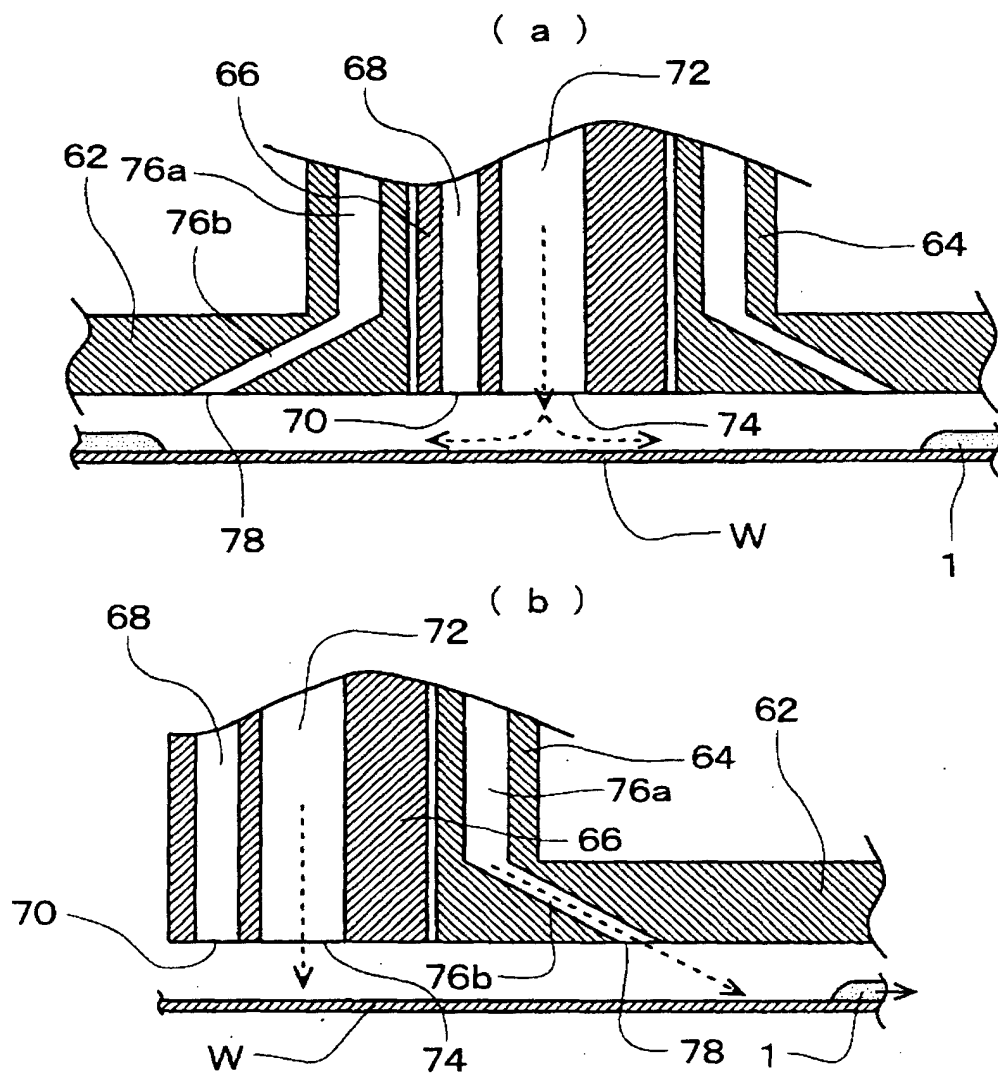
【図 9】



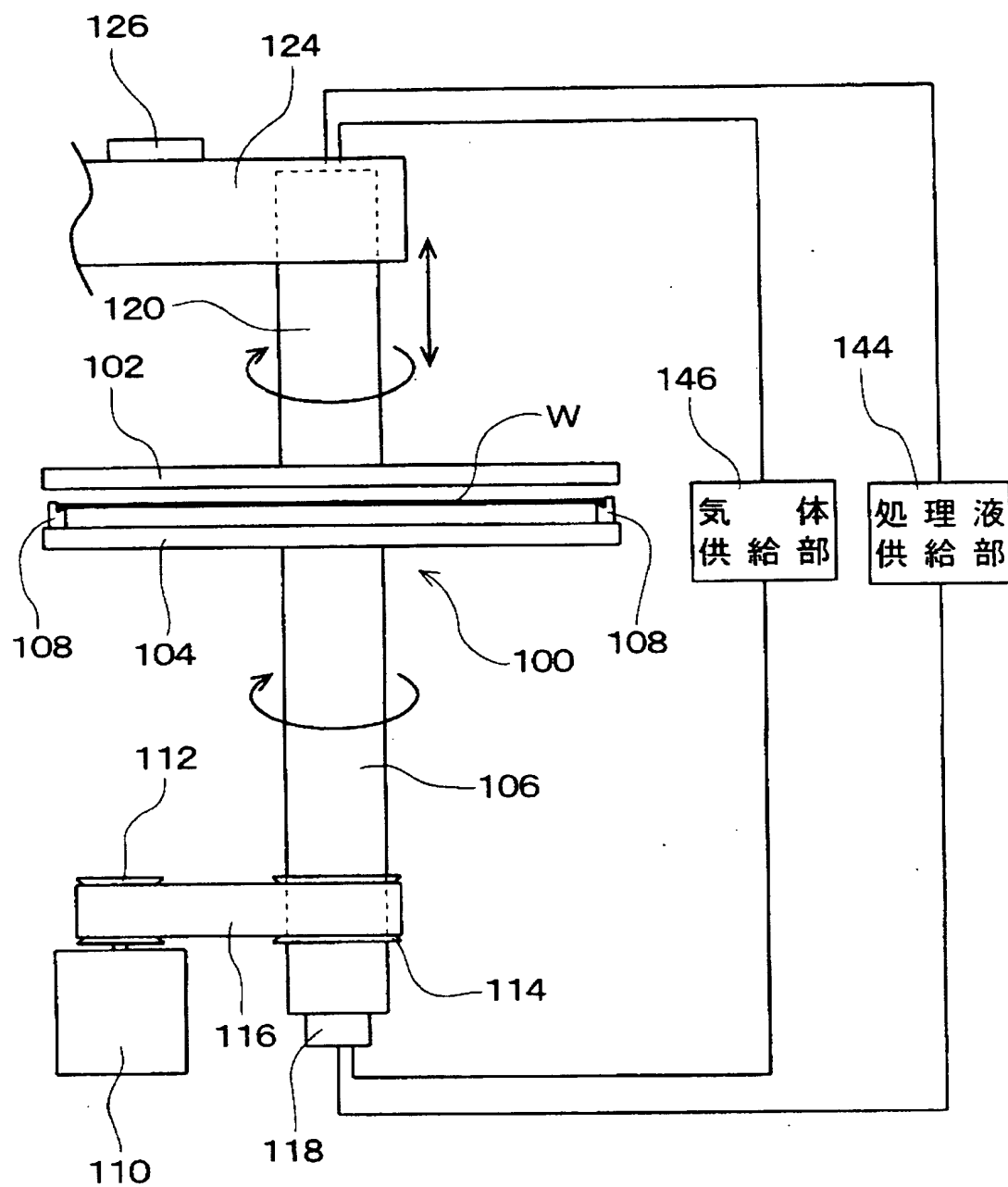
【図 10】



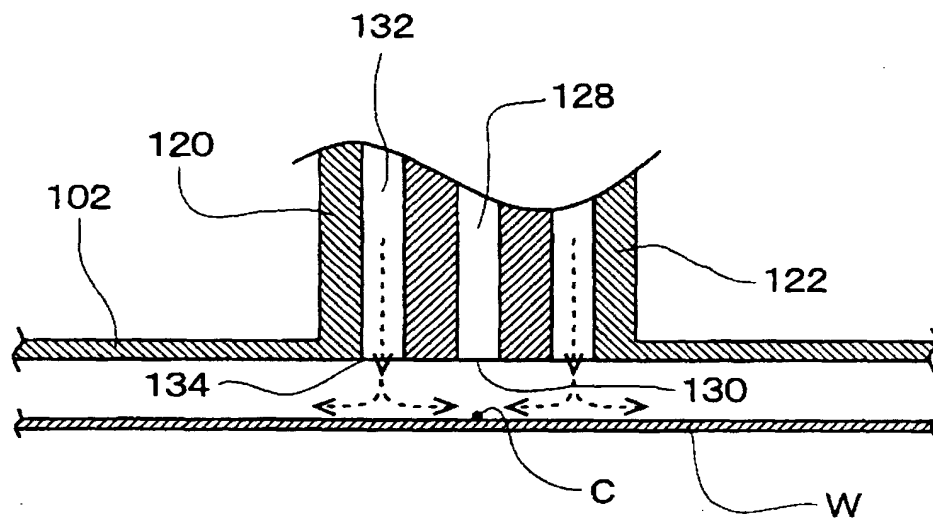
【図 1 1】



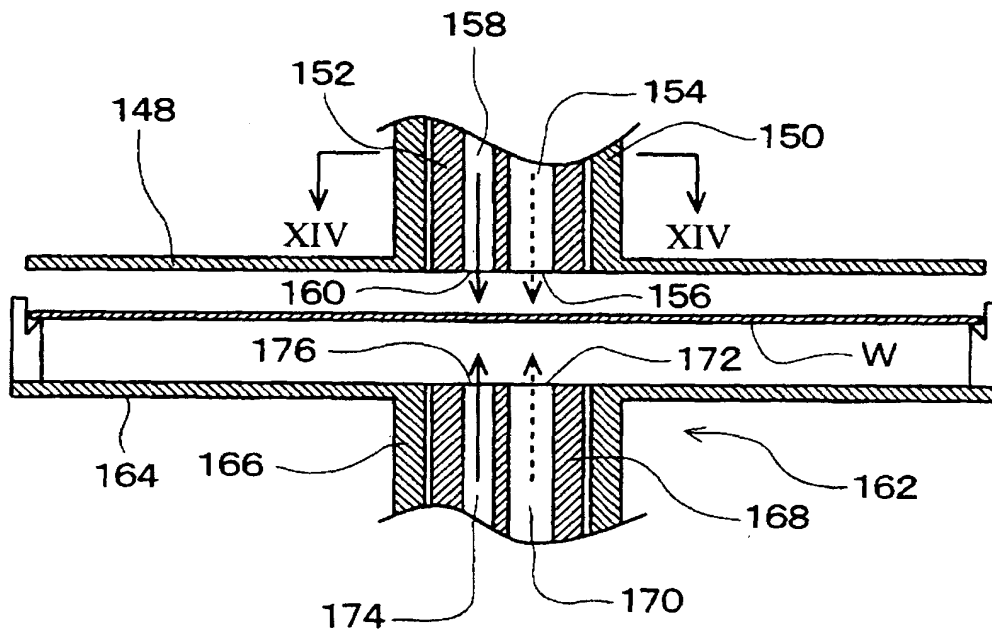
【図12】



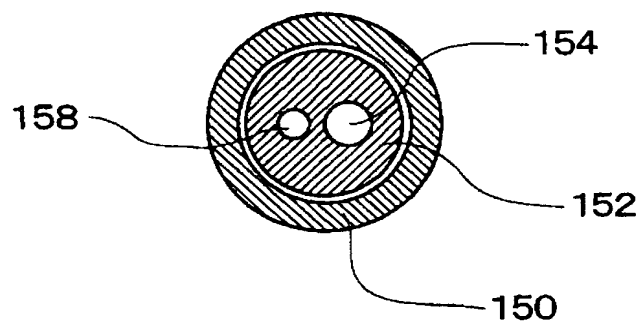
【図15】



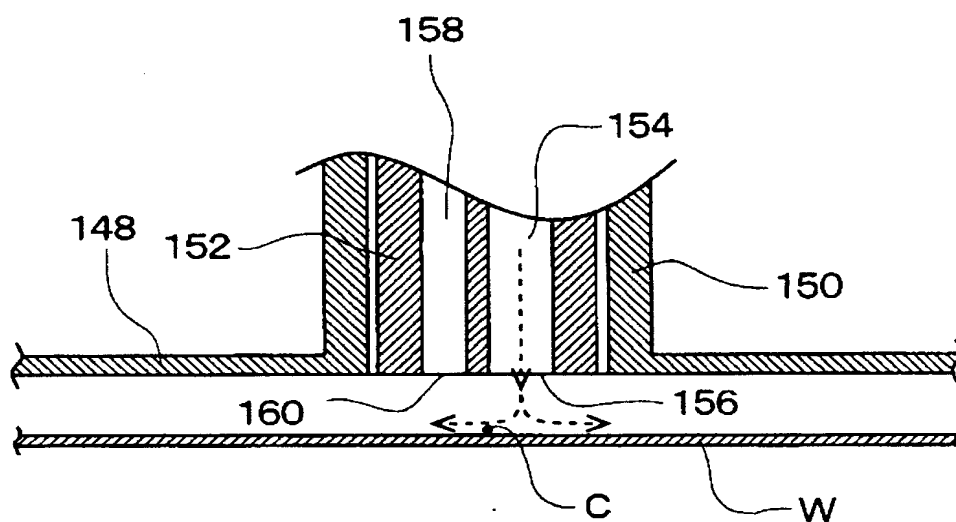
【図16】



【図 17】



【図 18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板を高速回転させてスピン乾燥させる前に、基板上に残っている液滴を効果的に排除することができる装置を提供する。

【解決手段】 基板処理装置は、基板Wを保持して回転させるスピンチャック 10 と、基板Wに対応する平面形状および大きさを有し、基板Wの上面に対向し近接して配置され、基板W上面の中央部へ処理液および気体をそれぞれ吐出する処理液吐出口 32 および気体吐出口 36 が形設された雰囲気遮断部材 12 とを備える。雰囲気遮断部材 12 の、平面視で気体吐出口 36 の外側に、基板Wの上面へ気体を吐出する外側気体吐出口 40 を形設した。外側気体吐出口 40 から吐出される気体の到達位置がスピンベース 14 に保持された基板Wの上面の中心と外周端縁との中間よりも中心側となるように、外側気体吐出口 40 を雰囲気遮断部材 12 に形設した。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 9 2 8 9 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 0 7 5 5 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 5 日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の
1

氏 名

大日本スクリーン製造株式会社